

типа, примерами которых служат известные уравнения Фишера и Колмогорова-Петровского-Пискунова.

В заключение отметим следующее. Широко распространено мнение, что макроскопически самодиффузию наблюдать нельзя, так как из-за тождественности молекул она не может проявиться ни при каком макроскопическом явлении. Для наблюдения самодиффузии надо как-то "пометить" часть молекул (см. стр. 347 в [8]). Из изложенного следует, что возможно наблюдение макроскопических проявлений самодиффузии, например, по затуханию звука, а также, разумеется, по спектрам рассеянного излучения.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Валандер С.В. // ДАН СССР. 1951. Т. 78. С. 25.
- [2] Слезкин Н.А. // ДАН СССР. 1951. Т. 77. С. 205.
- [3] Шапошников И.Г. // ЖЭТФ. 1951. Т. 21. С. 1309
- [4] Кач М. Несколько вероятностных задач физики и математики. М.: Наука, 1967.
- [5] Климонтович Ю.Л. Статистическая физика. М.: Наука, 1982.
- [6] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. М.: Наука, 1986.
- [7] Климонтович Ю.Л. // УФН. 1989. Т. 158. С. 59
- [8] Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 11. М.: Наука, 1975.

Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова

Поступило в Редакцию
23 февраля 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 9

12 мая 1990 г.

КОЛЛИНЕАРНОЕ МЕЖМОДОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕ-ТМ В ПЛАНАРНОМ ВОЛНОВОДЕ $LiNbO_3 : Ti : Fe$

И.И. Иткин, С.М. Шандаров

Преобразование мод ТЕ-ТМ, обусловленное фотопреломлением, в полосковых волноводах $LiNbO_3 : Ti$ наблюдалось в работах [1, 2]. Волноводы $LiNbO_3 : Ti : Fe$ обладают более высокой фотопреломлительной чувствительностью и позволяют наблюдать такие эффекты, как межмодовое ($TE_m - TE_n$) рассеяние голограмического типа [3]. В настоящей работе изучены особенности взаимодействия коллинеарно распространяющихся в планарном волноводе $LiNbO_3 : Ti : Fe$ γ -реза мод TE_3 и TM_3 ($\lambda = 0.63$ мкм) при котором формируется планарная голограммическая решетка (ГР) и наблюдается перекачка световой мощности из моды ТМ₃ в моду TE_3 .

Особенностью данного волновода, методика изготовления и основные параметры которого приведены в работе [3], является вы-

сокая темновая проводимость σ_T . Она обусловлена значительной концентрацией Fe (около 1 вес. %) в волноводном слое, и убывает с удалением от поверхности $y=0$. Для мод TE_3 и TM_3 , имеющих эффективные толщины $h_1=5.7$ мкм и $h_2=6.2$ мкм, σ_T существенно превышает фотопроводимость, но позволяет формировать планарные ГР с дифракционными эффективностями более 10% [4]. В исследуемом образце измеренные значения коэффициентов затухания $\alpha_1=0.4 \text{ см}^{-1}$, $\alpha_2=0.7 \text{ см}^{-1}$ для мод TE_3 , TM_3 с эффективными показателями преломления $n_1^*=2.2254$, $n_2^*=2.2833$, существенно различаются. Формируемая данными модами ГР имеет период $A=7.4$ мкм.

Уравнения для комплексных амплитуд взаимодействующих мод $C_1(x)$ и $C_2(x)$ в планарном волноводе с фоторефрактивной нелинейностью могут быть получены в виде

$$\begin{cases} \frac{dC_1}{dx} = -i\gamma^* \sqrt{\frac{h_2}{h_1}} |C_2|^2 C_1 - \alpha_1 C_1 \\ \frac{dC_2}{dx} = -i\gamma \sqrt{\frac{h_1}{h_2}} |C_1|^2 C_2 - \alpha_2 C_2. \end{cases} \quad (1)$$

От аналогичных уравнений для взаимодействия волн в объемных средах [5] система (1) отличается тем, что константа связи учитывает перекрытие полей взаимодействующих мод с наведенными ими оптическими неоднородностями.

В планарных волноводах, сформированных на $LiNbO_3$, возможно взаимодействие TE и TM мод, распространяющихся в направлении X . В этом случае, в отличие от объемной среды, вклад в формирование наведенного поля ГР (вектор ГР $\vec{K}_p \parallel OX$) будут давать как токи вдоль \vec{K}_p , так и по нормали к волноводному слою [6]. Для фотогальванического механизма нелинейности [5] имеем $\delta_1 \sim \beta_{15} E_3^{TE} E_1^{TM*}$, $\delta_2 \sim \beta_{24} E_3^{TE} E_2^{TM*}$, где β_{15} и β_{24} – компоненты фотогальванического тензора. Величина константы связи γ определяется также свертками $(E_3^{TE} \Delta \epsilon_3, E_1^{TM}) \sim r_{51} \epsilon_1$, $(E_3^{TM} \Delta \epsilon_{32} E_2^{TM}) \sim r_{42} \epsilon_2$, где $\Delta \epsilon_m$ – наведенные светом возмущения тензора диэлектрической проницаемости, r_{mn} – электрооптические постоянные. Вклад в $\Delta \epsilon_{mn}$ дают в волноводе две компоненты наведенного электрического поля ϵ_1 и ϵ_2 [6].

Точный расчет коэффициента связи возможен для волноводов со ступенчатым профилем показателя преломления $n(y)$ и фотогальванически активной примеси $N(y)$ [6]. Анализ показывает, что в таких волноводах основной вклад в γ дают составляющие тока δ_2 и наведенного поля ϵ_2 , ортогональные вектору решетки и направленные по нормали к поверхности волновода. Это качественно отличает рассматриваемые взаимодействия от процессов в объемных средах, где вклад в формирование ГР плоскими световыми волнами дает только составляющая тока, направленная по вектору \vec{K}_p [5]. Изученное в работе [1] преобразование мод $TE-TM$

полоскового волновода обусловлено токами и наведенными компонентами электрического поля, ортогональными K_p , но тангенциальными к поверхности подложки.

Волноводы на ниобате лития, обладающие хорошими фоторефрактивными свойствами ($LiNbO_3 : Fe$, $LiNbO_3 : Ti : Fe$) имеют профили $n(y)$ и $N(y)$, существенно отличающиеся от ступенчатого. Точный расчет параметров градиентных волноводов затруднен, поэтому для них целесообразно пользоваться понятиями эффективных констант [7]. Основные закономерности межмодовых взаимодействий в волноводах со ступенчатым профилем и градиентных структурах сохраняются, поэтому в эффективной константе связи $\tilde{\gamma}$ достаточно учесть вклад тока δ_2 и наведенного поля \mathcal{E}_2 . Принимая также темновую проводимость $\tilde{\sigma}_T$ существенно превышающей фотопроводимость, эффективную константу $\tilde{\gamma}$ представим в виде

$$\tilde{\gamma} = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{n_o^2 n_e^2 r_{42}}{\sqrt{n_1^* n_2^* h_1 h_2} \alpha} \cdot \frac{\tilde{\beta}_{24}}{\tilde{\sigma}_T} \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tilde{\tau}}\right) \right]. \quad (2)$$

Здесь n_o , n_e – показатели преломления кристалла; n_1^* , n_2^* – эффективные показатели преломления мод; $\tilde{\tau} = \epsilon_{22}^S / \tilde{\sigma}_T$ – время максвелловской релаксации.

В кристаллах симметрии $3m$ компонента β_{24} имеет симметричную и антисимметричную составляющие [8], поэтому константа связи здесь является комплексной ($\gamma = \gamma' + i\gamma''$). Как известно [7], мнимая часть γ'' определяет перекачку мощности между взаимодействующими модами. Анализ перекачки мощности для стационарного режима ($t \gg \tau$) проводился нами на основе численного интегрирования системы уравнений (1). На рис. 1 приведены расчетные зависимости нормированных мощностей волноводных мод $P_1(x)/P_{10}$ и $P_2(x)/P_{20}$ для волновода $LiNbO_3 : Ti : Fe$, параметры которого указаны выше. Мощности входных пучков принимались равными $P_{10} = 1$ мВт (мода TE), $P_{20} = 1.7$ мВт (мода TM_3), апертура $a = 0.4$ мм, что соответствовало условиям описанного ниже эксперимента. Расчеты проведены для двух значений мнимой части $\tilde{\gamma}''$, а ее знак в соответствии с данными для $LiNbO_3 : Fe$ [7] считался отрицательным. На рис. 1 представлены также зависимости $P_i(x)/P_{i0}$ для $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$. Как следует из рис. 1, в данном волноводе возможно усиление моды TE при достаточно больших значениях $\tilde{\gamma}''$ для некоторых длин взаимодействия. Затухание волноводных мод существенно изменяет картину перекачки мощности между ними.

Модуль константы связи $|\tilde{\gamma}|$ определяет эффективность дифракции на ГР [7], которая может быть найдена в аналитическом виде. Для этого будем считать ГР заданной, принимая в исходной системе (1) $|C_2|^2 C_1 = (C_1^o C_2^o)^* C_2$; $|C_1|^2 C_2 = (C_1^o C_2^o)^* C_1$; $C_1^o = C_{1,2}(0) \exp(-\alpha_{1,2} x)$. Решение выражается с помощью комбинаций функций Бесселя первого рода J_ν дробного порядка $\nu = \alpha_1/\alpha_1 + \alpha_2$

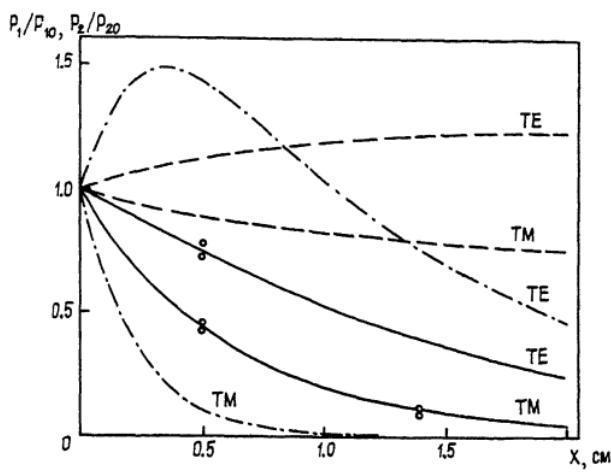


Рис. 1. Зависимость нормированной выходной мощности волноводных мод TE_3 , TM_3 от длины взаимодействия: сплошные линии — $\alpha_1=0.4 \text{ см}^{-1}$, $\alpha_2=0.7 \text{ см}^{-1}$, $\tilde{\beta}''=-0.21 \text{ м/Вт}$; пунктир — $\alpha_1=\alpha_2=0$, $\tilde{\beta}''=-0.21 \text{ м/Вт}$; штрих-пунктир — $\alpha_1=0.4 \text{ см}^{-1}$, $\alpha_2=0.7 \text{ см}^{-1}$, $\tilde{\beta}''=-2.1 \text{ м/Вт}$.

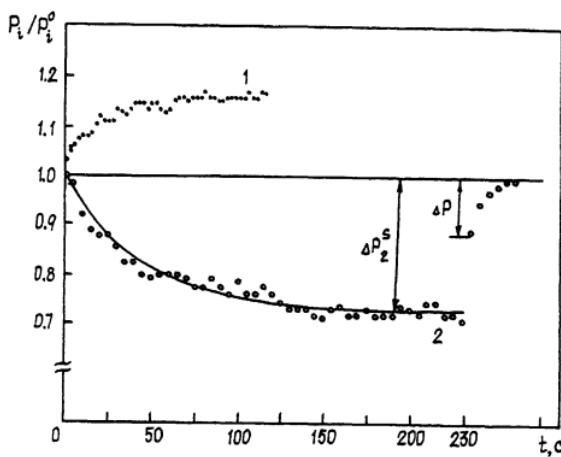


Рис. 2. Экспериментальная кинетика процесса перекачки мощности волноводных мод TE_3 (1) для $x_1=0.5 \text{ см}$ и TM_3 (2) для $x_2=1.4 \text{ см}$.

$$\gamma = \frac{P_2}{P_{10}} = \frac{AJ_\nu(b \exp[-(\alpha_1 + \alpha_2)x]) - J_{-\nu}(b \exp[-(\alpha_1 + \alpha_2)x])}{AJ_{(\nu+\nu)}(b) + J_{(\nu-\nu)}(b)} \exp[2(\alpha_1 + \alpha_2)x], \quad (3)$$

где $A=J_\nu(b)/J_\nu(b)$; $b=|\tilde{\beta}|C_1(0)C_2(0)/(\alpha_1 + \alpha_2)$. Сложный вид выражения обусловлен различием коэффициентов затухания взаимодействующих мод.

Экспериментально исследовались коллинеарные межмодовые процессы на длинах взаимодействия $x=0.5 \text{ см}$ и $x=1.4 \text{ см}$.

Входные пучки фокусировались сферической линзой с фокусным расстоянием $f=46$ см. Ввод и вывод излучения осуществлялся призмами из титаната стронция.

С момента включения пучков $t=0$ наблюдалась перекачка мощности из моды TM_3 (рис. 2) и ко времени $t=150$ с она достигла $\sim 30\%$ от $P_2^0(t=0)$ при длине взаимодействия $x=1.4$ см. Временная зависимость хорошо аппроксимировалась функцией $\Delta P_2 = \Delta P_2^S [1 - \exp(-t/\tilde{\tau})]$ с $\tilde{\tau}=42$ с. Направление перекачки от моды TM_3 к TE_3 указывает на то, что $\tilde{J}'' < 0$. Экспериментальные значения, характеризующие величину перекачки в стационарном режиме, представлены точками на рис. 1 и хорошо соответствуют расчетным кривым для $\tilde{J}'' = -0.21$ м/Вт. В момент времени $t=230$ с (рис. 2) пучок, возбуждающий TE -моду, был выключен, и по перепаду мощности TM -волны P была определена эффективность дифракции $\gamma = 10\%$. Из этой величины по формуле (3) найден модуль константы связи $|\tilde{J}| = 1.4$ м/Вт.

Используя найденные значения \tilde{J}'' , $|\tilde{J}|$, $\tilde{\tau}$ и материальные константы $LiNbO_3$ [9], мы вычислили темновую проводимость $\tilde{G}_T = 6 \cdot 10^{-12} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$ и фотогальваническую постоянную $\tilde{\beta}_{24} = (3.5-10.5) \cdot 10^{-13} \text{ А/Вт}$, величина которой соответствует известным оценкам для $\lambda = 0.63 \text{ мкм}$ [10].

Исследованный тип планарного взаимодействия не имеет объемного аналога, так как обусловлен составляющими фотогальванического тока и наведенного поля, направленными по нормали к волноводному слою. Он может быть использован для усиления и преобразований световых пучков в планарных волноводах.

Авторы благодарят С.Г. Одулова и В.М. Шандарова за участие в полезных обсуждениях результатов работы.

Список литературы

- [1] Божевольный С.И., Золотов Е.М., Казанский П.Г. и др. // Письма в ЖТФ. 1983. Т. 9. № 11. С. 690-692.
- [2] Wather C., Günter P. Proc. Int. Symp. Science and Technology. Erice, 6-17 July 1986 Berlin, 1987, p. 381-384.
- [3] Новиков А.Д., Одулов С.Г., Шандаров В.М., Шандаров С.М. // ЖТФ. 1988. Т. 58. № 8. С. 1604-1606.
- [4] Шандаров В.М., Шандаров С.М. // Письма в ЖТФ. 1986. Т. 12. № 1. С. 48-51.
- [5] Одулов С.Г., Стурман Б.И. // ЖЭТФ. 1987. Т. 92. С. 2016-2033.
- [6] Иткин И.И., Шандаров С.М. // Автометрия. 1989. № 4. С. 72-77.
- [7] Nisius J.P., Krätzig E. // Solid State Commun. 1985. V. 53. N 9. P. 743-746.

- [8] Стурман Б.И. // Квантовая электроника. 1980. Т. 7. № 3. С. 483-488.
- [9] Акустические кристаллы / Под редакцией М.П. Шаскольской. М.: Мир, 1982. 632 с.
- [10] Кухтарев Н.В., Семенец Т.И. // Украинский физический журнал. 1986. Т. 31. № 12. С. 1800-1807.

Поступило в Редакцию
3 февраля 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 9

12 мая 1990 г.

06.3; 07

© 1990

ОПТИЧЕСКИЙ ВОЛНОВОД НА ОСНОВЕ СТРУКТУРЫ $Si - SiO_2$

В.И. Аникин, П.М. Житков

В последние годы проявляется повышенный интерес к оптическим волноводным структурам на подложках из кремния. Создание таких структур позволяет осуществить интеграцию электронных и оптических компонентов на единой подложке. Волноводные структуры на кремниевых подложках, в которых в качестве волноводного слоя используется двуокись кремния (SiO_2), обладают крайне низкими оптическими потерями в широком спектральном диапазоне, позволяют обеспечить эффективнуюстыковку с оптическим волокном [1]. Методы, применяемые для изготовления этих волноводных структур, такие как термическое окисление кремния [2], осаждение из газовой фазы [2], гидролиз в пламени [3] являются высокотемпературными процессами (температура осаждения двуокиси кремния 450-1250 °C), что ограничивает область их применения при создании интегральных оптоэлектронных схем. Известные низкотемпературные методы получения двуокиси кремния, такие, например, как ВЧ распыление (температура осаждения < 200 °C), применялись только для изготовления гомогенных волноводных структур на подложках из плавленого кварца [4, 5]. В настоящей работе исследуется возможность применения ВЧ реактивного распыления для получения оптических волноводов из SiO_2 на кремниевых подложках.

При создании волновода из двуокиси кремния (показатель преломления SiO_2 на длине волны 0.6328 мкм равен 1.4573) для уменьшения потерь энергии волноводных волн в кремниевой подложке (комплексный показатель преломления кремния 3.85- $jx0.02$) между ней и волноводным слоем необходимо формировать буферный слой, изготовленный, например, из той же двуокиси кремния с более низким, чем у волноводного слоя, показателем преломления. На рис. 1 в качестве примера приведены расчетные зависимости